

東京大学生産技術研究所 光電子融合研究センター公開シンポジウム
ポスター発表リスト

ポスター番号	発表タイトル	著者	所属
1	A MEMS Reconfigurable Metamaterial for Terahertz Filter Applications	Zhengli Han, Kenta Kohno, Hiroyuki Fujita, Kazuhiko Hirakawa, and Hiroshi Toshiyoshi	東大生研
2	三次元半導体キラルフォトニック結晶における円偏光操作	高橋駿(1)、田尻武義(2)、太田泰友(1)、館林潤(1)、岩本敏(1,2,3)、荒川泰彦(1,2,3)	(1)東大ナノ量子機構、(2)東大生研、(3)東大生研・光電子融合研究センター
3	励起子キラリティーを示す有機化合物の磁気光学効果	服部伸吾(1)、赤川賢吾(2)、工藤一秋(2)、石井和之(1)	(1) 東大生研・光電子融合研究センター、(2) 東大生研
4	フォトニック・アモルファス構造体における光禁制帯形成	小見山雄一郎、阿部紘之、枝川圭一	東大生研
5	H0型フォトニック結晶ナノ共振器-単一量子ドット結合系を用いた共振器量子電磁力学	太田泰友(1)、高宮大策(2)、太田竜一(2)、熊谷直人(1)、石田悟己(2)、岩本敏(1,2,3)、荒川泰彦(1,2,3)	(1)東大ナノ量子機構、(2)東大生研、(3)東大生研・光電子融合研究センター
6	Spin wave emission in rare-earth iron garnet by linearly polarized light pulses	吉峯功、佐藤琢哉、志村努	東大生研・光電子融合研究センター
7	表面弾性波を用いた電子スピン輸送と無磁場ESR	眞田治樹(1)、国橋要司(1)、後藤秀樹(1)、小野満恒二(1)、好田誠(2)、新田淳作(2)、Paulo V. Santos(3)、寒川哲臣(1)	(1) NTT物性基礎研、(2) 東北大工、(3) Paul Drude Institute
8	単一分子トランジスタにおける量子輸送現象とその外場応答	吉田健治(1)、坂田修一(1)、岡村直柔(1)、北川裕一(1)、石井和之(1)、平川一彦(1,2)	(1)東大生研・光電子融合研究センター、(2)東大ナノ量子機構
9	Quantum interference in a ballistic graphene n-p-n junction: from Fabry-Perot to edge channel interference	Sei Morikawa(1), Satoru Masubuchi(1,2), Rai Moriya(1), Kenji Watanabe(3), Takashi Taniguchi(3), Tomoki Machida(1,2)	(1)東大生研、(2)東大ナノ量子機構、(3)NIMS
10	単一プラズモニック粒子の光誘起マルチカラー変化	齋藤滉一郎、田邊一郎、立間徹	東大生研・光電子融合研究センター
11	銀薄膜上GaAsナノワイヤにおける表面プラズモンポラリトンのファブリ・ペローモードの観測	J. F. Ho (1), 館林潤(1), S. Sergent(1), C.F. Fong(1), 岩本敏(1,2), 荒川泰彦(1,2)	(1)東大ナノ量子機構、(2)東大生研
12	金属クラスターを用いた光機能素子	中村英司、古郷敦史、坂井伸行、立間徹	東大生研・光電子融合研究センター
13	自己触媒法によるInP/InAsヘテロナノワイヤの作製及び光特性	Guoqiang Zhang (1), 館野功太 (1), 納富雅也(1,2), 寒川哲臣 (1), 後藤秀樹 (1)	(1)NTT物性基礎研、(2)NTT NPC
14	量子ドットナノワイヤ構造を用いた単一光子源の実現	権晋寛(1), 太田泰友(2), 渡邊克之(2), 岩本敏(1,2), 荒川泰彦(1,2)	(1)東大生研、(2)東大ナノ量子機構
15	室温動作GaNナノワイヤ量子ドット単一光子源	マークホームズ(1)、崔琦鉉(1)、加古敏(2)、有田宗貴(1)、荒川泰彦(1,2)	(1)東大ナノ量子機構、(2)東大生研
16	GaN界面ゆらぎ量子ドットの形成と光電子物性	有田宗貴(1)、壹岐太一(2)、加古敏(2)、荒川泰彦(1,2)	(1)東大ナノ量子機構、(2)東大生産研・光電子融合研究センター
17	光照射KFMによるCIGS太陽電池における光励起キャリア再結合プロセスの評価	龍顯得(1)、峯元高志(3)、高橋琢二(1,2)	(1)東大生研、(2)東大ナノ量子機構、(3)立命館大理工
18	中間バンド型量子ドット太陽電池の理論解析とその特性評価	野澤朋宏 (1,2,3)、都木宏之 (1,2)、渡邊克之 (1)、荒川泰彦 (1,2)	(1)東大ナノ量子機構、(2)東大生研、(3)シャープ
19	ケルビンプローブフォース顕微鏡によるCIGS太陽電池の物性評価	石井智章(1)、峯元高志(3)、高橋琢二(1,2)	(1)東大生研、(2)東大ナノ量子機構、(3)立命館大理工

東京大学生産技術研究所 光電子融合研究センター公開シンポジウム
ポスター発表リスト

20	リブロン光散乱法によるソフト界面の分子ダイナミクス計測	古賀俊行、美谷周二朗、酒井啓司	東大生研
21	局在プラズモン共鳴による光電流増強	川脇徳久、朝倉彰洋、渡邊智、立間徹	東大生研・光電子融合研究センター
22	金属/MoS ₂ /グラフェン縦型FET構造における巨大電流変調と光-電子変換デバイスへの可能性	守谷頼(1)、山口健洋(1)、井上義久(1)、増淵覚(1,2)、町田友樹(1,2)	(1)東大生研、(2)東大ナノ量子機構
23	フタロシアニン錯体を用いた光電気化学的酸素還元	松本駿亮、石井和之	東大生研・光電子融合研究センター
24	合金ナノ粒子によるプラズモン誘起電荷分離	西弘泰、立間徹	東大生研・光電子融合研究センター
25	Non-radiative Recombination Property in CIGS Solar Cells Investigated through Photothermal Atomic Force Microscopy	Srivises Warithapol(1)、Takashi Minemoto(3)、Takuji Takahashi(1,2)	(1)東大生研、(2)東大ナノ量子機構、(3)立命館大理工
26	Optical measurement of heat transfer in Si nanostructures	Jeremie Maire(1,2)、鹿毛雄太(1)、野村政宏(1,3)	(1)東大生研CIRMM、(2)LIMMS-CNRS/IIS、(3)東大ナノ量子機構
27	Stimulated Raman scattering in silicon photonic crystal waveguides with modified holes	Yi-Hua Hsiao(1)、Satoshi Iwamoto(1,2)、and Yasuhiko Arakawa(1,2)	(1)東大生研・光電子融合研究センター、(2)東大ナノ量子機構
28	Si上に直接成長したGeの時間分解発光分光	加古敏(1)、小田克矢(2,3,4)、谷和樹(2,3,4)、井戸立身(2,3,4)、荒川泰彦(1)	(1)東大生研、(2)PETRA、(3)PECST、(4)日立中研
29	Terahertz response of single self-assembled InAs quantum dots	Y. Zhang(1)、K. Shibata(1,2)、N. Nagai(1)、C. Ndebeka-Bandou(1,3)、G. Bastard(1,3)、and K. Hirakawa(1,2)	(1)東大生研・光電子融合研究センター、(2)東大ナノ量子機構、(3)Ecole Normale Supérieure
30	Graphene nanoribbon infrared bolometer	Miho Arai(1)、Masahiro Onuki(1)、Satoru Masubuchi(1,2)、and Tomoki Machida(1,2)	(1)東大生研、(2)東大ナノ量子機構
31	ウェハ接合によるSi基板上InAs/GaAs量子ドットレーザの進展	田辺克明(1)、荒川泰彦(1,2)	(1)東大ナノ量子機構、(2)東大生研・光電子融合研究センター
32	Electrically Pumped InAs/GaAs Quantum Dot Lasers on Silicon-on-Insulator Substrate by Metal-Stripe Wafer Bonding	Y. H. Jhang(1)、田辺克明(2)、岩本敏(1,2)、荒川泰彦(1,2)	(1)東大生研、(2)東大ナノ量子機構
33	GaAs量子井戸中をドリフトする電子スピンのゲート電界制御	国橋要司(1)、眞田治樹(1)、後藤秀樹(1)、小野満恒二(1)、好田誠(2)、新田淳作(2)、寒川哲臣(1)	(1)NTT物性基礎研、(2)東北大工
34	アスコルビン酸検出用蛍光プローブの開発:TEMPOラジカル結合型フタロシアニン	横井孝紀、石井和之	東大生研・光電子融合研究センター
35	Growth of InAs/GaAs stacked quantum dots with high optical quality on Ge/Si substrate and demonstration of electroluminescence at 1.3 um for silicon photonics application	Mohan Rajesh (1)、Katsuaki Tanabe (1,2)、Satoshi Kako (1,2)、Makoto Miura (2,3)、and Yasuhiko Arakawa (1,2,4)	(1)東大ナノ量子機構、(2)PECST、(3)PETRA、(4)東大生研